

## บทที่ 3

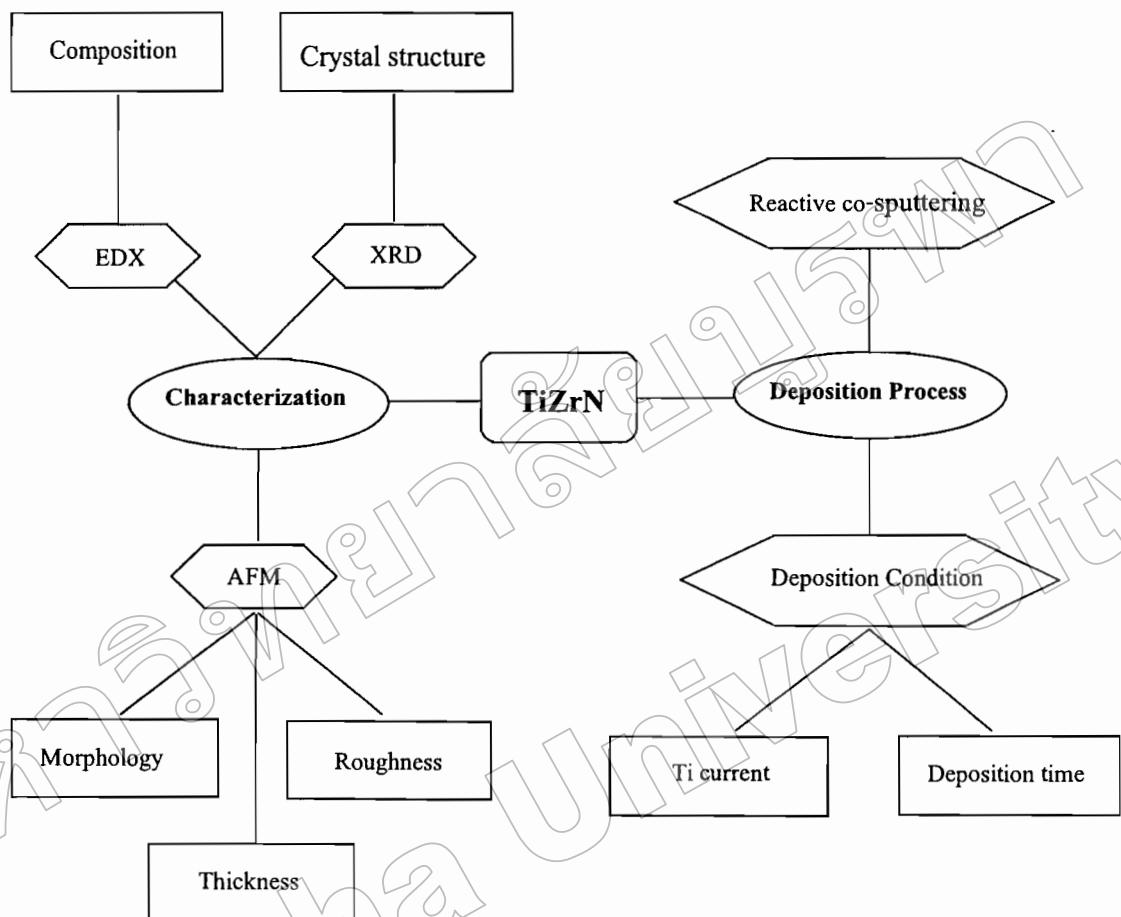
### วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้กล่าวถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย ตลอดรวมถึงขั้นตอนและวิธีการทดลอง ดังเดียวกับการเตรียมพิล์มนบาง ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ ตลอดจนการศึกษาลักษณะเฉพาะของพิล์มนบาง ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### กรอบแนวคิดของงานวิจัย

ผู้วิจัยแบ่งการดำเนินงานของวิทยานิพนธ์เป็น 2 ส่วนคือ (1) การเตรียมพิล์มนบาง ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ (2) การศึกษาลักษณะเฉพาะของพิล์มนบาง ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ สรุปได้ดังนี้

ในส่วนการเตรียมพิล์มนบาง ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์นั้น ขั้นแรกจะศึกษาอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลือบพิล์มนบาง ตัวแปรต่าง ๆ และขั้นตอนการเคลือบ ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้ ใช้การเคลือบด้วยเทคนิครีแอคติฟโคลสปิตเตอริง จากนั้นจึงทดลองเคลือบพิล์มนบาง ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ โดยศึกษาผลของกระแสไฟฟ้าของเม็ดไทเทเนียม และเวลาในการเคลือบ พิล์มนบาง ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ ที่มีต่อลักษณะเฉพาะและสมบัติของพิล์มนบางที่เตรียม ได้ ส่วนการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพิล์มนบาง ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ ที่เคลือบ ได้ ผู้วิจัยจะนำไปหาลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิค XRD เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึก เทคนิค เพื่อศึกษา ลักษณะพื้นผิวและความหนา และเทคนิค EDX เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชาตุทางเคมี



ภาพที่ 3-1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย

## เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) การเตรียมพิล์มนบาง ไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์ (2) การหาลักษณะเฉพาะของพิล์มนบาง ไทเทเนียมเชอร์โโคเนียม ในไตรค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 1. การเตรียมพิล์มนบาง ไทเทเนียมเชอร์โโคเนียม ในไตรค์

1.1 เครื่องเคลือบสูญญากาศระบบบริแอคติฟโคลสปัตเตอร์ ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ เครื่องเคลือบที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้น โดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสูญญากาศและพิล์มนบาง ภาควิชา ฟิสิกส์คอมพิวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพที่ 3-2)

### 1.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

#### 1.2.1 เป้าสารเคลือบ (Target) มี 2 ชนิดคือ

- ไทเทเนียม ความบริสุทธิ์ 99.97%
- เชอร์โโคเนียม ความบริสุทธิ์ 99.95 %

#### 1.2.2 วัสดุรองรับ (Substrate) มี 2 ชนิดคือ

- กระเจกสไลด์
- แผ่นซิลิโคน

#### 1.2.3 แก๊ส (Gas) มี 2 ชนิดคือ

- แก๊สอะร์กอนบริสุทธิ์ 99.999% เป็นแก๊สสปัตเตอร์ (Sputtered Gas)
- แก๊สในไตรเจนบริสุทธิ์ 99.999% เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา (Reactive Gas)

### 2. การหาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพิล์มนบาง ไทเทเนียมเชอร์โโคเนียม ในไตรค์

2.1 X-Ray Diffractrometer สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึก งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง X-Ray Diffractrometer รุ่น Rint 2000 (Rigaku Corporation) ของภาควิชาโลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาพที่ 3-3)

2.2 Atomic Force Microscope สำหรับศึกษาความหนา และลักษณะพื้นผิว งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง Atomic Force Microscope รุ่น Nanoscope IV (Veeco Instruments Inc.) ของศูนย์ เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาพที่ 3-4)

2.3 Field Emission Scanning Electron Microscope และ Energy Dispersive X-ray spectroscopy (Hitachi s-4700) สำหรับศึกษาองค์ประกอบทางเคมี (ภาพที่ 3-5)



ภาพที่ 3-2 เครื่องเคลื่อนสุญญากาศบนรีแอคเตอร์โคลัมป์ต่อริงที่ใช้ในงานวิจัย



ภาพที่ 3-3 เครื่อง X-Ray Diffractrometer



ภาพที่ 3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope (AFM) in a tapping mode,

by Digital Instruments, Nanoscope III

(a) AFM and display part

(b) AFM probe and sample stage

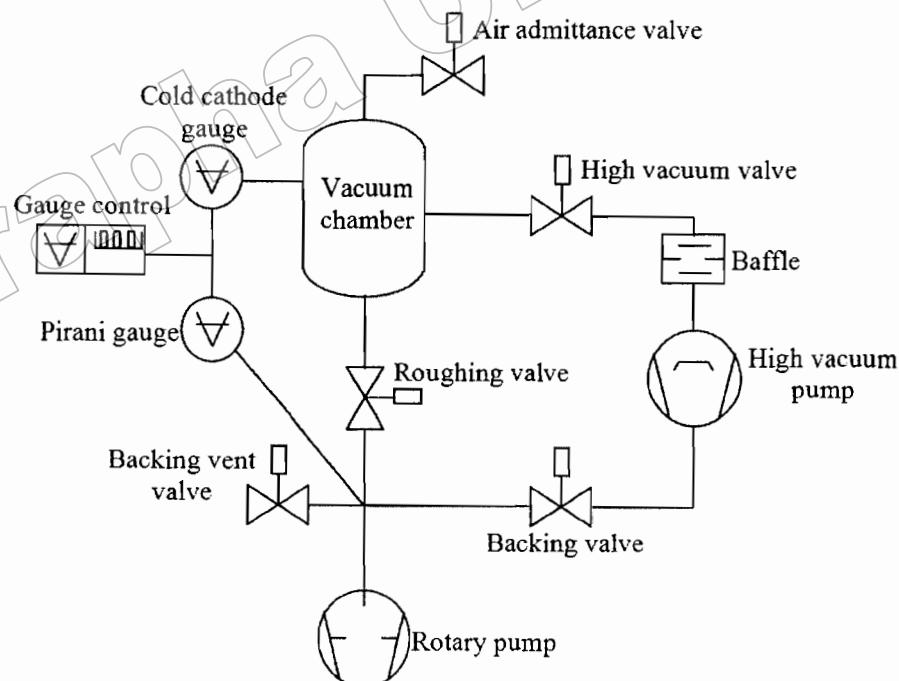


ภาพที่ 3-5 เครื่อง FE-SEM และ EDX

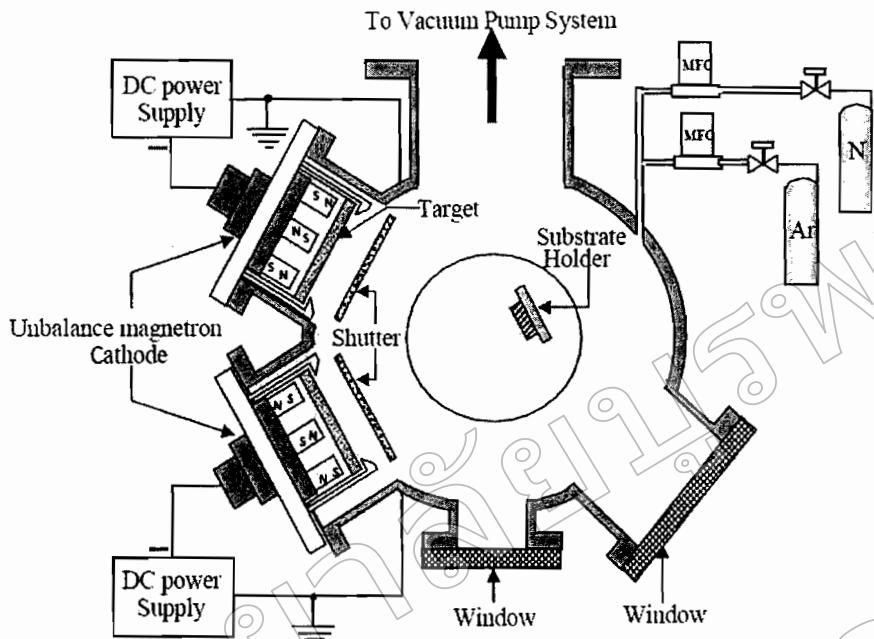
## เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบบริแอคตีฟโคสปัตเตอริง

การเตรียมฟิล์มบาง ไทเทเนียมเชอร์โโคเนี่ยม ในไตรด์ (TiZrN) ในงานวิทยานิพนธ์นี้ ใช้เทคนิครีแอคตีฟโคสปัตเตอริง (Reactive Co-Sputtering) ซึ่งเป็นกระบวนการภายใต้สภาวะสูญญากาศ ดังนั้นเพื่อให้ฟิล์มบางที่ได้มีคุณภาพและสมบัติตามที่ต้องการ จะต้องลดความดันภายในภาชนะสูญญากาศให้อยู่ในระดับ  $10^{-5}$  mbar ส่วนประกอบของเครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของระบบสูญญากาศ (Vacuum Part System) และส่วนของระบบการเคลือบ (Coating Part System) มีรายละเอียดดังนี้

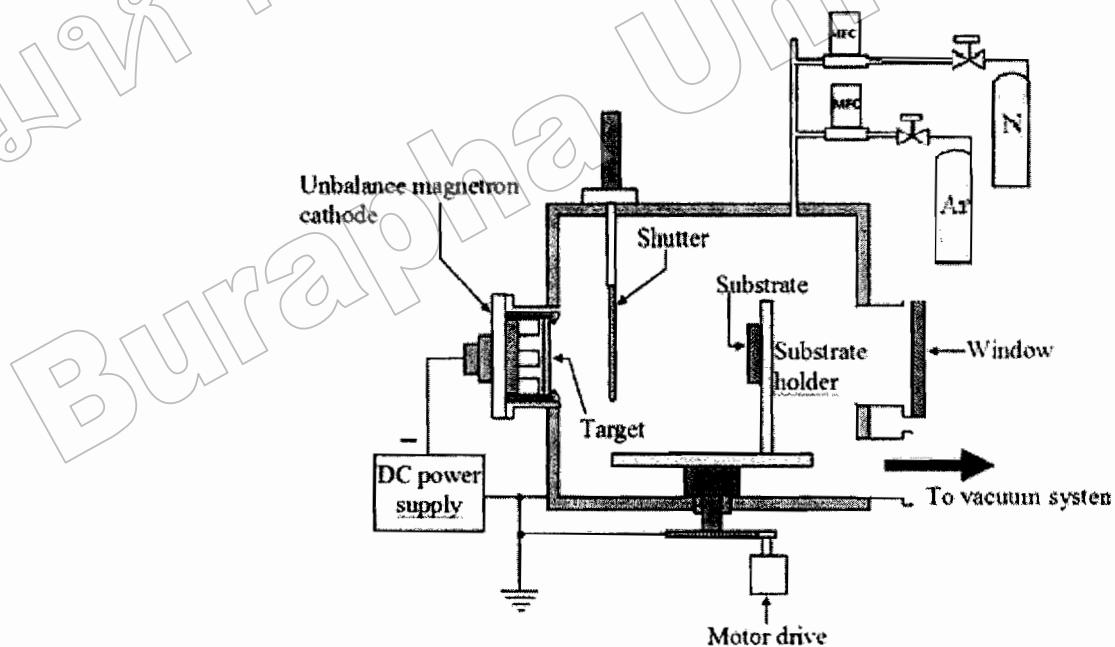
- ส่วนของระบบสูญญากาศ (Vacuum Part System) ประกอบด้วย ห้องเคลือบ ทรงกระบอกทำจากสแตนเลส มีขนาดเดือนผ่านศูนย์กลาง 310.0 mm สูง 370.0 mm ระบบเครื่องสูบน้ำสูญญากาศของเครื่องเคลือบประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร์โทแบบระบบนายความร้อนด้วยน้ำ และมีเครื่องสูบกล/rootar เป็นเครื่องสูบท้าย สำหรับการวัดความดันภายในภาชนะสูญญากาศใช้มาตรวัดความดันของ Balzers รุ่น TPG300 โดยใช้หัววัดแบบพิรา尼 รุ่น TPR010 และหัววัดแบบเพนนิ่ง รุ่น IKR050 ภาพที่ 3-5 เป็นผังระบบสูญญากาศของเครื่องเคลือบ (สำหรับใช้ในการตรวจสอบระบบสูญญากาศ) ภาพที่ 3-6 และภาพที่ 3-7 เป็นໄดอะแกรนของเครื่องเคลือบที่ใช้ในงานวิจัย



ภาพที่ 3-6 ผังระบบสูญญากาศของเครื่องเคลือบที่ใช้ในงานวิจัย

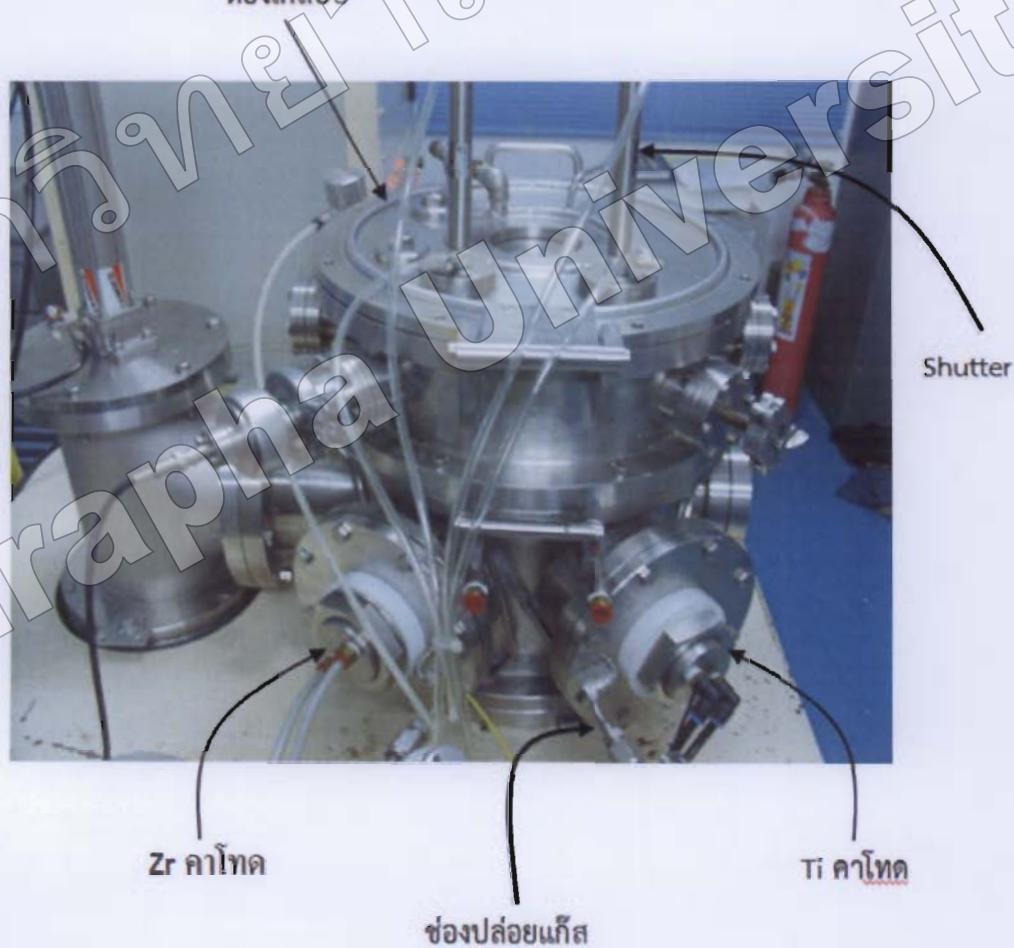


ภาพที่ 3-7 ลักษณะของเครื่องเคลือบที่ใช้ในงานวิจัยเมื่อมองจากด้านบน (Top View)

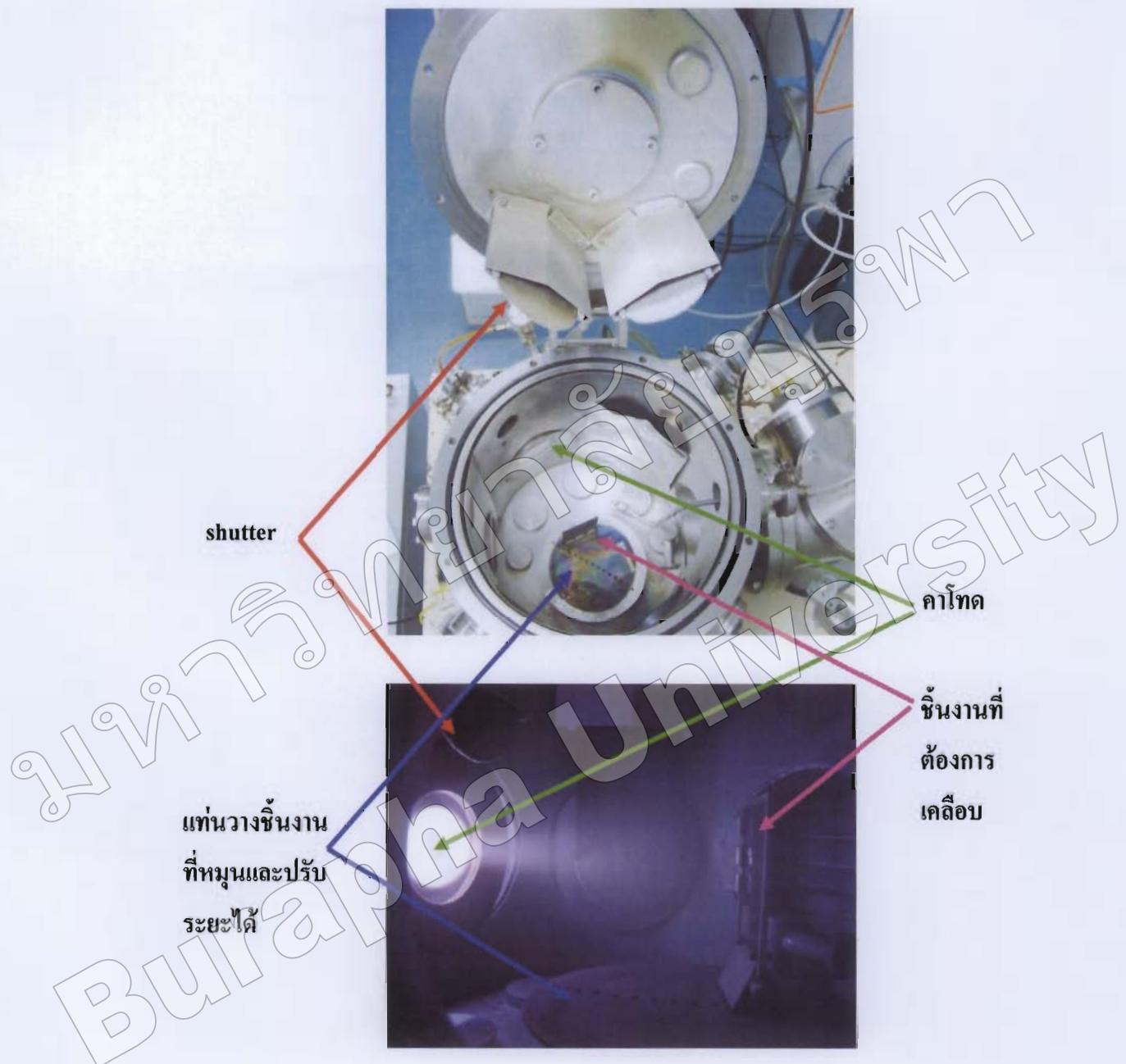


ภาพที่ 3-8 ลักษณะของเครื่องเคลือบที่ใช้ในงานวิจัยเมื่อมองจากด้านข้าง (Side View)

2. ส่วนของระบบการเคลือบ (Coating Part System) เป็นส่วนสำหรับเตรียมพิล์มบางไทเทเนียมเชอร์โโคเนี่ยน ในไตรค์ โดยการเคลือบบนวัสดุรองรับชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วยแมกนีตรอนคาโทด แบบระนาบความร้อนด้วยน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 75.0 mm จำนวน 2 ชุด ที่ติดตั้งด้านข้างของห้องเคลือบ พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงขนาด 1000 V 3 A สำหรับการจ่ายแก๊สที่ใช้ในกระบวนการเคลือบ (แก๊สอาร์กอนและแก๊สไนโตรเจน) จะควบคุมด้วยเครื่องควบคุมอัตราไหลของแก๊ส (Mass Flow Controller) (ภาพที่ 3-9) ภายในห้องเคลือบมีแท่นวางชิ้นงานที่ถูกดึงห้องเคลือบซึ่งสามารถหมุนและปรับระดับหางจากหน้าเป้าสูรเคลือบได้



ภาพที่ 3-9 ลักษณะ/ตำแหน่งของคาโทดทั้งสองชุดที่ใช้ในกระบวนการเคลือบ



ภาพที่ 3-10 ลักษณะภายในของห้องเคลือบและลักษณะพลาสม่าขณะเคลือบ

## การสร้างสภาวะสุญญากาศ

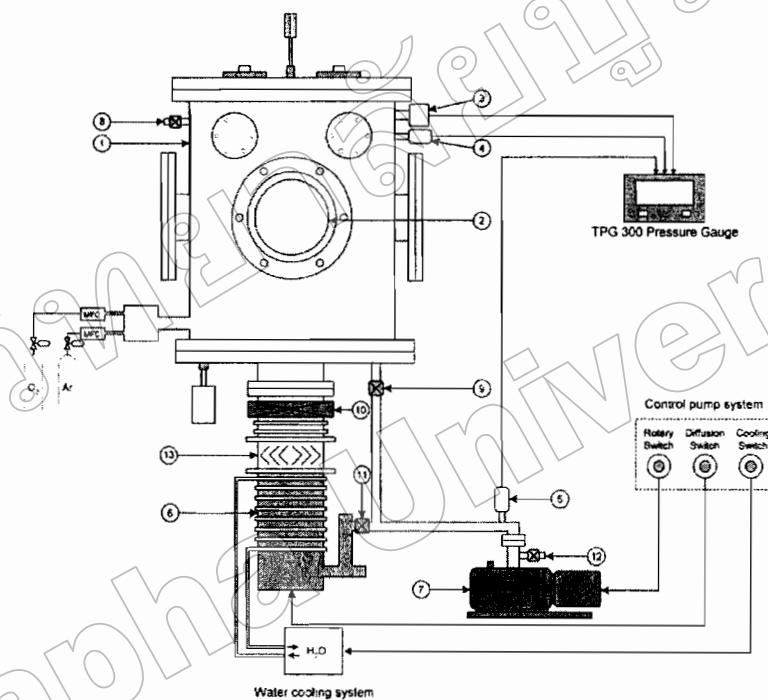
ก่อนทำการเคลือบฟิล์มด้วยวิธีสปิตเตอริง ต้องทำความดันในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศที่ระดับสุญญากาศสูง (High Vacuum) ความดันประมาณ  $10^{-3}$  -  $10^{-5}$  mbar เพื่อลดการปนเปื้อนของฟิล์มที่เคลือบได้น่องจากการคงค้างของแก๊สในภาชนะสุญญากาศ (Residual Gas) การสร้างสภาวะสุญญากาศจะใช้ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ ไอ (Diffusion Pump) หนุนหลังด้วยเครื่องสูบกลโตรารี (Rotary Pump) ที่ต่อเข้ากับภาชนะสุญญากาศ ด้วยท่อและมีวาล์วควบคุมการปิด-เปิด (ภาพที่ 3-11) โดยในตอนต้นจะใช้เครื่องสูบกลโตรารีเพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากาศจากความดันบรรยายกาศเป็นความดันต่ำประมาณ  $10^{-2}$  mbar ต่อมาจะใช้เครื่องสูบแบบแพร่ ไอ เพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากาศจาก  $10^{-2}$  mbar ให้ลดลงอยู่ในช่วงความดัน  $10^{-5}$  mbar

สำหรับขั้นตอนการสร้างภาวะสุญญากาศมีดังนี้

1. ตรวจเช็ค瓦ล์วหยาบ (หมายเลข 9) วาล์วท้ำย (หมายเลข 11) และวาล์วสุญญากาศสูง (หมายเลข 10) ให้อยู่ในสภาพปิดทั้งหมด
2. เปิดสวิตซ์หลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบต่าง ๆ ของเครื่อง เช่น ระบบวัดความดัน และระบบควบคุมการทำงานของระบบเครื่องสูบสุญญากาศเป็นต้น หลังจากนั้นเปิดสวิตซ์ Rotary เพื่อให้เครื่องสูบกลโตรารี (หมายเลข 7) ทำงาน
3. เริ่มสูบอากาศจากเครื่องสูบแบบแพร่ ไอ โดยใช้เครื่องสูบกลโตรารี โดยเปิดวาล์วท้ำย เพื่อให้เครื่องสูบกลโตรารีสูบอากาศออกจากเครื่องสูบแบบแพร่ ไอ (หมายเลข 6) จนความดันในเครื่องสูบแบบแพร่ ไอ เมื่ออ่านจากพิรานีเกจ (หมายเลข 4) มีค่า้อยกว่า  $10^{-2}$  mbar ซึ่งเป็นความดันที่เครื่องสูบแบบแพร่ ไอ สามารถทำงานได้ พร้อมทั้งเปิดสวิตซ์ Diffusion เพื่อให้ตัวทำงานร้อนของเครื่องสูบแบบแพร่ ไอทำงานเป็นการเริ่มต้นนั่มัน ใช้ประมาณ 20 นาที
4. ในระหว่างการต้มน้ำมันนำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวางในภาชนะสุญญากาศ โดยก่อนวางวัสดุรองรับต้องตรวจความดันใน ภาชนะสุญญากาศยังคงอยู่ในสภาวะเป็นสุญญากาศ หรือไม่ ถ้าซึ่งเป็นสุญญากาศที่ทำการปิดวาล์วปล่อย เพื่อให้อากาศเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศ จนความดันในภาชนะสุญญากาศเท่ากับความดันบรรยายกาศ หลังจากนั้นทำการเปิดฝาครอบภาชนะสุญญากาศออก นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบไปวาง ปิดฝาครอบและปิดวาล์วปล่อยให้สนิท
5. สร้างสภาวะสุญญากาศขั้นต้นในภาชนะสุญญากาศโดยใช้เครื่องสูบกลโตรารี โดยการปิดวาล์วท้ำย และปิดวาล์วหยาบเพื่อให้เครื่องสูบกลโตรารีสูบอากาศออกจากภาชนะสุญญากาศ จนความดันในภาชนะสุญญากาศ มีค่าประมาณ  $10^{-2}$  mbar เมื่ออ่านความดันจากมาตรวัดความดันแบบช่วงกว้าง (หมายเลข 3)

6. เมื่อคัมภีร์น้ำมันจันครบ 20 นาที ทำการสร้างสภาวะสุญญากาศสูง ในภาชนะสุญญากาศด้วยเครื่องสูบแบบแพร์โไอ โดยปิดวาล์วหยาบแล้วเปิดวาล์วท้าย หลังจากนั้นเปิดวาล์วสุญญากาศสูงเพื่อให้เครื่องสูบแบบแพร์โไอสูบอากาศออกจากภาชนะสุญญากาศเพื่อทำความสะอาดด้านในภาชนะสุญญากาศให้ออยู่ในระดับสภาวะสุญญากาศสูง หรืออยู่ในช่วง  $10^{-5}$  -  $10^{-6}$  mbar

7. จับเวลาและร่องความดันในภาชนะสุญญากาศมีค่าประมาณ  $5 \times 10^{-5}$  mbar ซึ่งกำหนดให้เป็นค่าความดันพื้น ( $P_0$ ) ก่อนเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มนางเชอร์โคเนียมออกไซด์



ภาพที่ 3-11 ไดอะแกรมระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ของระบบเคลือบสปีตเตอริง

- |  |  |
|--|--|
| 1. ภาชนะสุญญากาศ (Vacuum Chamber)        | 2. หน้าต่าง (Window)                     |
| 3. มาตรวัดความดันเพนนิ่ง (Penning Gauge) | 4. มาตรวัดความดันพิรา尼 (Pirani Gauge)    |
| 5. มาตรวัดความดันแบบพิรา尼 (Pirani Gauge) | 6. เครื่องสูบแบบแพร์โไอ (Diffusion Pump) |
| 7. เครื่องสูบกลไคร (Rotary Pump)         | 8. วาล์วปล่อย (Vent Valve)               |
| 9. วาล์วหยาบ (Roughing Valve)            | 10. วาล์วสุญญากาศสูง (High Vacuum Valve) |
| 11. วาล์วท้าย (Backing Valve)            | 12. วาล์วปล่อย (Vent Valve)              |
| 13. แบฟเฟล (Baffle)                      |  |

## การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟลั่มนางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมในไตรค์

ทั้งนี้ก่อนนำวัสดุรองรับมาเคลือบฟลั่มต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ได้แก่ คราบฝุ่น ไขมันสารอินทรีย์ต่าง ๆ ก่อน ซึ่งจะทำให้ได้ผิววัสดุรองรับที่ไม่มีความสะอาด ทำให้ฟลั่มที่เคลือบยึดติดแน่นลงบนผิวน้ำของวัสดุรองรับ สำหรับการทำความสะอาดวัสดุรองรับ เริ่มจากนำวัสดุรองรับไปล้างด้วยไครคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) โดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปล้างด้วยอะซิโตนโดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 5 นาที แล้วนำไปล้างต่อ ด้วยไอโซโพรพาโนล (Isopropanol) โดยใช้อัลตราโซนิกส์อีก 5 นาที นำวัสดุรองรับขึ้นด้วยคีนคีน เป่าด้วยลมร้อนให้แห้ง จากนั้นนำวัสดุรองรับใส่เข้าในภาชนะสูญญากาศเพื่อรอการเคลือบ ดังแสดงในภาพที่ 3-12



ภาพที่ 3-12 การล้างวัสดุรองรับ

## การเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์

การเคลือบฟิล์มบางในภาชนะสูญญากาศด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงถูกติดตั้งเข้ากับระบบเคลือบโดยต่อ ศักย์ไฟฟ้าลงเข้ากับขั้วคาโทดและต่อศักย์ไฟฟ้าบวก (Ground) กับภาชนะสูญญากาศ เป้าไทเทนเนียมและเป้าเซอร์โคเนียมจะถูกติดตั้งกับขั้วคาโทด โดยด้านบนของคาโทดจะต่อ กับระบบไหเวียนน้ำเย็นเพื่อใช้ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณคาโทดจากการสปีตเตอร์ของไหอ่อน อาร์กอนที่บริเวณผิวน้ำเป้าสารเคลือบ ส่วนวัสดุรองรับถูกวางบนแผ่นรองรับที่ติดตั้งบนแท่นวาง ที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ โดยชัตเตอร์ (Shutter) ใช้สำหรับกันระหว่างวัสดุรองรับกับเป้าสาร เคลือบ เพื่อป้องกันการเคลือบผิววัสดุรองรับในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดหน้าเป้า (Pre Sputtering) และอุปกรณ์ Control Unit ที่เชื่อมต่อกับ Mass Flow Controller (MFC) ใช้นั่งกับ การทำงานของเครื่องควบคุมการปล่อยแก๊สอย่างละเอียด เพื่อควบคุมอัตราการไหลงแก๊ส อาร์กอนและออกซิเจนที่เข้าสู่ภาชนะสูญญากาศ โดยค่าอัตราการไหลงของแก๊สจะมีหน่วยเป็น Standard Cubic Centimeter per Minute at STP (sccm)

ขั้นตอนในการเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์ มีรายละเอียดดังนี้

1. นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวางไว้บนแท่นวางวัสดุรองรับ ปิดชัตเตอร์หน้า เป้าไทเทนเนียมและเป้าเซอร์โคเนียม แล้วปิดฝาภาชนะสูญญากาศ
2. ลดความดันภายในภาชนะสูญญากาศเหลือ  $5 \times 10^{-5}$  mbar กำหนดเป็นค่าความดันพื้น ( $P_b$ ) ของระบบก่อนทำการเคลือบฟิล์ม บันทึกค่าความดัน  $P_b$  ที่อ่านได้
3. ทำความสะอาดหน้าเป้าสารเคลือบด้วยกระบวนการ Pre-Sputtering เป็นเวลา 3 นาที
4. ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มโดยเริ่มจากการปล่อยแก๊สอาร์กอนและแก๊สไนโตรเจน เข้าสู่ภาชนะสูญญากาศ ตามค่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการทดลอง
5. จ่ายศักย์ไฟฟ้าลงให้แก่คาโทด จนเกิดโกลว์ดิสชาร์จ (ชัตเตอร์ยังคงปิดอยู่) เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้คาโทดและกระแสคาโทดที่วัดได้ไม่เปลี่ยนแปลง จะเริ่มการเคลือบฟิล์มบาง โดยปิดชัตเตอร์ที่ปิดหน้าเป้าออก เพื่อเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มลงบนวัสดุรองรับ พร้อมทั้ง บันทึกผลค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ( $\Delta V$ ) ค่ากระแสไฟฟ้า ( $I$ ) และความดันรวม ( $P_t$ ) ที่เกิดขึ้นขณะเริ่ม เคลือบฟิล์ม และทำการเคลือบฟิล์ม ตามเวลา ( $t$ ) ที่กำหนด
6. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบฟิล์ม ปิดแหล่งจ่ายไฟ ปิดแก๊สอาร์กอน ปิดแก๊สไนโตรเจน และปล่อยอากาศเข้าไปในภาชนะสูญญากาศ เพื่อนำวัสดุรองรับออก



ภาพที่ 3-13 การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรด์

## การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มนาง

งานวิจัยนี้ แบ่งการศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มนางที่เคลือบได้ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) โครงสร้างผลึกของฟิล์ม (2) ลักษณะพื้นผิวและความหนาฟิล์ม (3) องค์ประกอบบนฐานทางเคมีของฟิล์ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงสร้างผลึกของฟิล์ม ขั้นนี้เป็นการนำฟิล์มนางที่เคลือบได้มาศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึก ค่าคงที่เดทดิช โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 โครงสร้างผลึกของฟิล์ม ศึกษาโดยนำแผ่นซิลิกอนที่เป็นวัสดุรองรับที่เคลือบแล้ว นำวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Diffractrometer โดยใช้  $\text{Cu}-\text{k}\alpha$  เป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ตรวจวัดใน Mode Low Angle ด้วยมุมตั้งกระทำงที่เท่ากับ  $3^\circ$  กำหนดมุมวัดอยู่ในช่วง  $20^\circ - 80^\circ$  สเปกตรัมที่วัดได้บันทึกในรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

ปกติการระบุหรือยืนยันโครงสร้างผลึกของวัสดุใด ๆ สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของวัสดุที่ต้องการทราบกับฐานข้อมูล JCPDS สำหรับในงานวิจัยนี้ วัสดุที่ศึกษาก็คือ ฟิล์มไบทেเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสารประกอบชนิดใหม่ที่รวมตัวกันในลักษณะของสารละลายของแข็ง (Solid Solution) ทำให้ยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล JCPDS ดังนั้นการระบุหรือยืนยันโครงสร้างของฟิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้ จึงไม่มีข้อมูลมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบ จึงพิจารณาจากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบได้ กับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไบทे�เนียมในไตรด์ และเซอร์โคเนียมในไตรด์ จากการแทนที่ของอะตอมเซอร์โคเนียมในโครงสร้างของไบทे�เนียมในไตรด์ ซึ่งอะตอมเซอร์โคเนียมมีขนาดใหญ่กว่าอะตอมไบทे�เนียม ทำให้ระยะห่างระหว่างระนาบของผลึกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ลดลง เมื่อเทียบกับไบทे�เนียมในไตรด์ (Hasegawa, Kimura, & Suzuki, 2000) หรือเกิดจากการแทนที่ของอะตอมไบทे�เนียมในโครงสร้างของเซอร์โคเนียมในไตรด์ ซึ่งอะตอมไบทे�เนียมมีขนาดเล็กกว่าอะตอมเซอร์โคเนียม ทำให้ระยะห่างระหว่างระนาบของผลึกลดลง จึงส่งผลให้มีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเซอร์โคเนียมในไตรด์ ดังนั้นมุนการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบได้ ต้องมีค่าอยู่ระหว่างมุนการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไบทे�เนียมในไตรด์ และเซอร์โคเนียมในไตรด์ ซึ่งสอดคล้องกับสมการการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จากผลึก (Bragg's Law) ดังสมการ

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda \quad (3-1)$$

โดยที่  $\lambda$  คือความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์  $n$  คือลำดับของการสะท้อน  $d_{hkl}$  คือระยะห่างระหว่างระนาบ ( $h k l$ ) และ  $\theta$  คือมุมตั้งกระทำงและมุมสะท้อนเมื่อวัดจากแนวระนาบที่กำลังพิจารณา

1.2 ขนาดผลึกของฟิล์ม สำหรับการหาขนาดผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้ ทางจากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractrometer โดยใช้ Scherrer Equation ในการคำนวณหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรด์ที่ได้หลังการเคลือบ ดังสมการ

$$L = \frac{k\lambda}{\beta \cos\theta} \quad (3-2)$$

เมื่อ  $L$  คือ ขนาดของผลึกฟิล์ม ไทเทเนียมเชอร์โโคเนียม ในไตรด์

$k$  คือ ค่าคงที่เท่ากับ 0.9

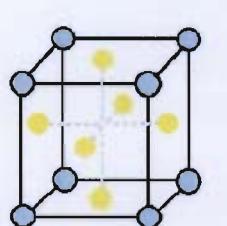
$\lambda$  คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ ( $\text{CuK}_\alpha = 1.5406$ )

$\beta$  คือ ความกว้างครึ่งหนึ่งของพิกที่มีค่าความเข้มสูงสุด

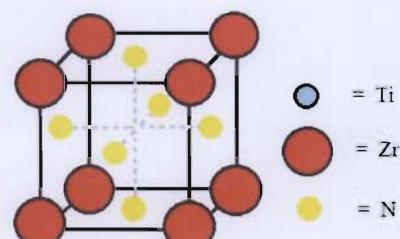
$\theta$  คือ ครึ่งหนึ่งของมุมตรงจุดศูนย์กลางพิก

1.3 ค่าคงที่แลตทิซของฟิล์ม ( $a, b, c$ ) ทางกรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยใช้สมการการหาระยะห่างระหว่างระนาบผลึกของฟิล์ม ไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรด์ ซึ่ง Ramana et al. (2004) ได้ศึกษาโครงสร้างของฟิล์มบาง ( $\text{Ti}, \text{Zr})\text{N}$  แล้วพบว่ามีโครงสร้างแบบเฟช เช็นเตอร์ คิวบิก (FCC) ดังภาพที่ 3-14 การแทนที่ของอะตอมในโครงสร้างของไทเทเนียมในไตรด์หรือเชอร์โโคเนียมในไตรด์นั้น จึงส่งผลให้ค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มที่เคลือบได้ ต้องมีค่าอยู่ระหว่างค่าคงที่แลตทิซของไทเทเนียมในไตรด์และเชอร์โโคเนียมในไตรด์

$$\text{ระยะห่างระหว่างระนาบผลึกแบบคิวบิก;} \quad d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (3-3)$$



(a)

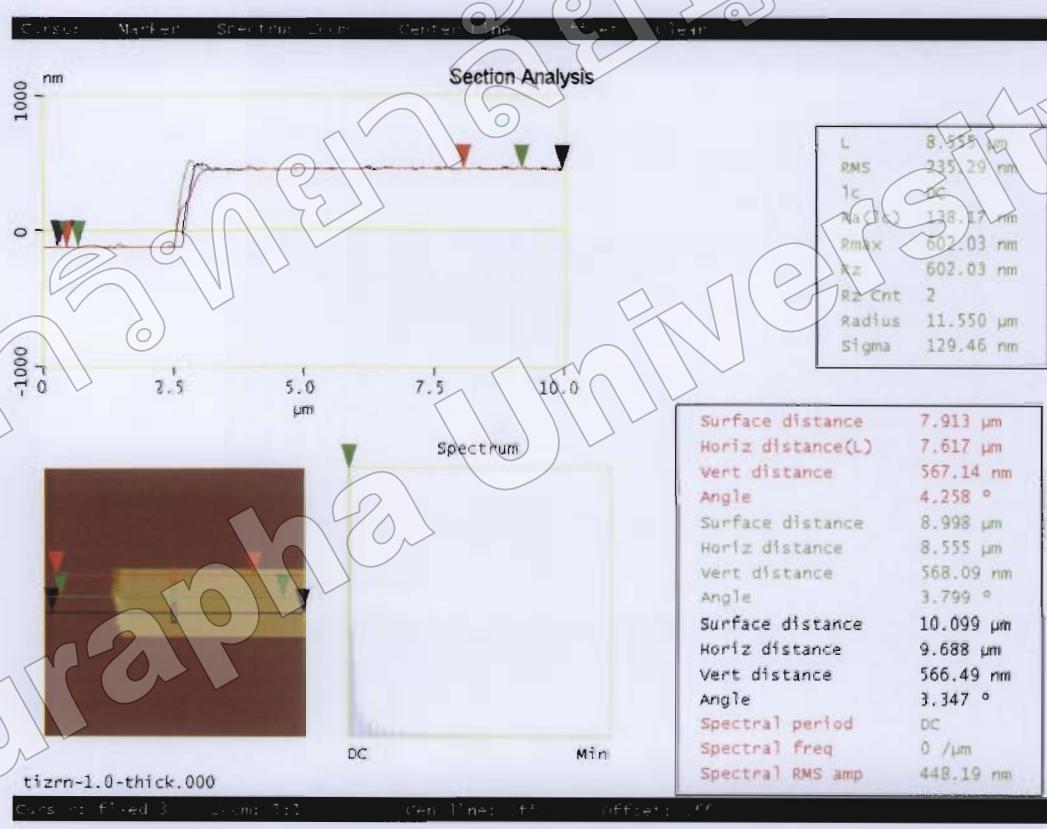


(b)

ภาพที่ 3-14 ระบบผลึกแบบเฟช เช็นเตอร์ คิวบิก (a) ไทเทเนียมในไตรด์ (b) เชอร์โโคเนียมในไตรด์

2. ลักษณะพื้นผิวและความหนาฟิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการนำฟิล์มบางที่เคลือบได้มาศึกษา ลักษณะพื้นผิวและความหนาด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การหาความหนาฟิล์ม โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้ว ไปวิเคราะห์ความหนาด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยใช้เข็มขนาดเล็กทำจากซิลิกอนในไตรด์ เคลื่อนที่กรอบบนผิวฟิล์มบางที่มีความสูงต่างหากกันไป โดยตัวคานมีเข็มเกาะติดอยู่จะมีการโถ้งงอ บริเวณด้านบนจะมีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ และมีไฟโตกีฬา เสริมสำหรับวัดการโถ้งของคานยืน แสดงผลดังภาพที่ 3-15

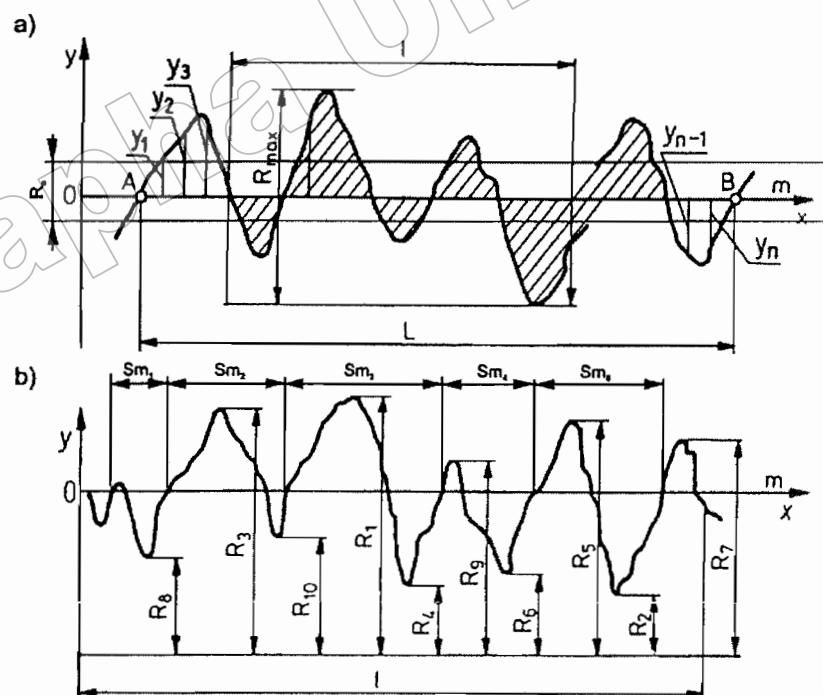


ภาพที่ 3-15 ตัวอย่างผลการตรวจความหนาฟิล์มด้วยเทคนิค AFM

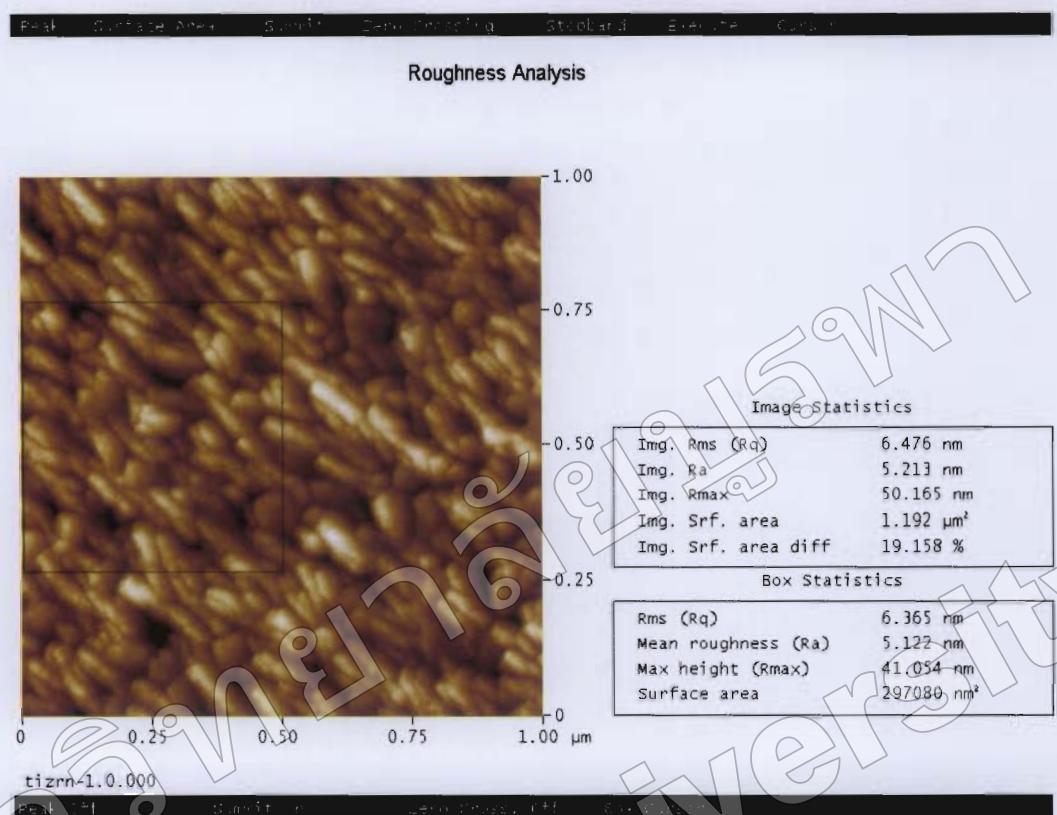
2.2 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิโคนที่ผ่านกระบวนการเคลื่อนແล้าไววิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยมีความละเอียดในระดับนาโน และใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์เท่ากับ  $1 \times 1 \mu\text{m}^2$  พร้อมวัดค่าความหยาบผิว โดยใช้เข็มตรวจวัดขนาดเล็กที่ทำการซิลิโคนในไตรค์ เคลื่อนที่กราดไปทั่วบริเวณต่างๆ ของผิววัสดุ สภาพผิวที่แตกต่างกันไปจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเข็มตรวจวัดแตกต่างกันไป โดยตัวคานมีเข็มเกาะติดอยู่จะมีการโถ้งงอ ปริมาณการโถ้งงอนี้สามารถตรวจได้โดยใช้ไฟฟ้าดีแทกเตอร์ แสดงผลดังภาพที่ 3-17 โดยใช้สมการหาค่าความหยาบผิวกำลังสองเฉลี่ย (Root-Mean-Square Roughness,  $R_{\text{rms}}$ ) ดังสมการ

$$R_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2} \quad (3-4)$$

เมื่อ  $n$  คือ จำนวนคำແນ່ນที่มีค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของบริเวณพื้นผิวที่ทำการวัด  
 $Z_i$  คือ ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของแต่ละคำແນ່ນบนพื้นผิว  
 $\bar{Z}$  คือ ความสูงเฉลี่ย



ภาพที่ 3-16 ตัวอย่างการหาความหยาบผิวเฉลี่ย (Burakowski, 1998)



ภาพที่ 3-17 ตัวอย่างผลการตรวจวัดลักษณะผิวฟิล์มด้วยเทคนิค AFM

3. องค์ประกอบของชาตุทางเคมีของฟิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการนำฟิล์มที่เคลือบได้มาศึกษาองค์ประกอบของชาตุทางเคมี ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDX)

## แนวทางการทดลอง

การทดลองในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเตรียมพิล์มนบางไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์บันกระเจสไลค์และแผ่นชิลิกอน ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ จากนั้นนำพิล์มนไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์ที่เคลือบได้ไปวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง โดยแต่ละการทดลองมีขั้นตอนการทดลองสรุปได้ดังนี้

### การทดลองที่ 1 ผลของกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียม

วัตถุประสงค์ เพื่อหาระยะไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมที่เหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มนบางไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์

### วิธีการทดลอง

1. การเตรียมพิล์มนบางไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์ที่กระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมค่าງๆ ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบพิล์มนบางไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์บันกระเจสไลค์และแผ่นชิลิกอนโดยการแปรค่ากระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมในกระบวนการเคลือบ เพื่อหาระยะไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมที่เหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มนบางไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-1

เมื่อนำวัสดุรองรับที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาใส่ในภาชนะสูญญากาศ

โดยระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเท่ากับ 13 cm และสร้างสภาวะสูญญากาศให้ได้ความดันพื้นเท่ากับ  $5 \times 10^{-3}$  mbar จากนั้นทำการ吸附หน้าเป้าสารเคลือบด้วยแก๊สอาร์กอนเป็นเวลา 3 นาที เสร็จแล้วเคลือบพิล์มนบางไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์ ตามเงื่อนไขในตารางที่ 3-1 โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนโตรเจนคงที่เท่ากับ 8 sccm : 6 sccm และแปรค่ากระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมเท่ากับ 0.6 A, 0.8 A และ 1.0 A ตามลำดับ ควบคุมความดันรวมขณะเคลือบให้คงที่เท่ากับ  $5 \times 10^{-3}$  mbar และใช้เวลาเคลือบนาน 60 นาที

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพิล์มนบางไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์ ขั้นตอนนี้เป็นการนำพิล์มนบางไทเทเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์ที่เคลือบได้มาศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึก ค่าคงที่แลดทิช ความหนา ลักษณะพื้นผิว และองค์ประกอบธาตุ

ตารางที่ 3-1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์ที่กระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทนเนียมต่าง ๆ

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	ไทเทนเนียม, เชอร์โโคเนียม
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	$5.0 \times 10^{-5}$
ความดันรวม (mbar)	$5.0 \times 10^{-3}$
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	13
อัตราไหลงแก๊สอาร์กอนต่อไนโตรเจน (scm)	8 : 6
กระแสไฟฟ้าไทเทนเนียม (A)	0.6, 0.8, 1.0
เวลาเคลือบ (min)	60

การทดลองที่ 2 ผลของเวลาในการเคลือบ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของเวลาในการเคลือบต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทนเนียม

เชอร์โโคเนียมในไตรค์

วิธีการทดลอง

- การเตรียมฟิล์มบางไทเทนเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์ที่เวลาในกระบวนการเคลือบต่าง ๆ ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์บนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนโดยการแบ่งเวลาในการเคลือบเพื่อศึกษาผลของเวลาต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทนเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-2

เมื่อนำวัสดุรองรับที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาใส่ในภาชนะสูญญากาศ โดยการทดลองนี้แบ่งเวลาในการกระบวนการเคลือบ แล้วสร้างสภาวะสูญญากาศให้ได้ความดันพื้นเท่ากับ  $5 \times 10^{-5}$  mbar จากนั้นทำการเคลือบหน้าเป้าสารเคลือบด้วยแก๊สอาร์กอนเป็นเวลา 3 นาที เสร็จแล้วเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมเชอร์โโคเนียมในไตรค์ตามเงื่อนไขในตารางที่ 3-2 โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สอาร์กอนต่อเก๊าในไนโตรเจนคงที่เท่ากับ 8 scm : 6 scm และแบ่งเวลาในการเคลือบทั้งหมดเท่ากับ 15, 30, 45 และ 60 นาที ตามลำดับ ควบคุมความดันรวมขณะเคลือบให้คงที่เท่ากับ  $5 \times 10^{-3}$  mbar กระแสไฟฟ้าของเป้าสารเคลือบคงที่ (การทดลองที่ 1)

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทนเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ขั้นตอนนี้เป็นการนำฟิล์มบางไทเทนเนียมเซอร์โคเนียมในไตรค์ที่เคลือบได้มาศึกษา โครงสร้างผลึกขนาดผลึกค่าคงที่แลดทิช ความหนา ลักษณะพื้นผิว และองค์ประกอบทางเคมี

ตารางที่ 3-2 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมเซอร์โคเนียมในไตรค์ที่เวลาการเคลือบต่างๆ

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	ไทเทนเนียม, เซอร์โคเนียม
วัสดุรองรับ	กระเจกสไลด์ และแผ่นซิลิโคน
ความดันพื้น (mbar)	$5.0 \times 10^{-5}$
ความดันรวม (mbar)	$5.0 \times 10^{-3}$
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	13
อัตราส่วนแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนโตรเจน (sccm)	8 : 6
เวลาเคลือบ (min)	15, 30, 45, 60